



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра общей и экспериментальной физики



СВЕРЖДАЮ
Декан физического факультета
П.М. Буднев
2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля): **БЗ.Б.6** Процессы микро- и нанотехнологии

Направление подготовки: 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Профиль подготовки: Материалы и компоненты твердотельной электроники

Степень (квалификация) выпускника - бакалавр

Форма обучения: очная.

Согласовано с УМК:

физического факультета

Протокол № 38

от « 18 » апреля 2023 г.

Зам. председателя, к.ф.-м.н., доцент

 В.В. Чумак

Рекомендовано кафедрой:

общей и экспериментальной физики

Протокол № 7

от « 31 » января 2023 г.

Зав. кафедрой, д.ф.-м.н., профессор

 А.А. Гаврилюк

Иркутск 2023 г.

Содержание

	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины (модуля)	3
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)	3
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины (модуля)	5
5.1 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)	5
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)	6
5.3 Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий	7
6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ.	8
7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)	9
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):	9
а) основная литература;	9
б) дополнительная литература;	9
в) программное обеспечение;	9
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы	9
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).	10
10. Образовательные технологии	10
11. Оценочные средства (ОС).	10

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):

Цель дисциплины:

Дисциплина предусмотрена учебным планом с целью формирования у студентов знаний о физико-химических основах базовых технологических процессов, применяемых при производстве микроэлектронных приборов с микронными и субмикронными размерами активных областей и рабочих слоев, а также знаний об основах проектирования технологических циклов производства простейших микроэлектронных структур.

Задачи дисциплины:

Основной задачей дисциплины является привитие навыков самостоятельной разработки технологии изготовления различных микроэлектронных структур, изучение процесса разработки эскизов шаблонов для фотолитографии, разработки последовательности технологических операций изготовления микроэлектронной структуры, включая методы изоляции. развитие у студентов общих представлений о физических основах технологии производства изделий электроники

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина “ Процессы микро- и нанотехнологий ” является дисциплиной профессионального цикла и относится к основной части. Код учебного цикла БЗ. Дисциплина “ Процессы микро- и нанотехнологий “ опирается на математическую дисциплину ”Математический анализ” (код дисциплины Б2.Б1.1), школьные дисциплины “Физика” и “Химия” и читается параллельно с курсом “ Физическая химия материалов” (код дисциплины Б3.В.ДВ.3.1).

Освоение дисциплины необходимо для освоения курсов ”Твердотельная электроника” (код дисциплины Б3.В.ДВ.1.1), “ Магнитные материалы функциональной электроники ” (код дисциплины Б3.В.ДВ.6.1), “Основы проектирования электронной компонентной базы” (код дисциплины Б3.В.ОД.3).
Общая трудоемкость - 4 зачетных единицы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1. Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики.

ОПК -6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

В результате изучения дисциплины студент должен:

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения)

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	47/1,32	47/1,30
В том числе:	-	
Лекции	14/0,38	14/0,38
Практические занятия (ПЗ)	28/0,77	28/0,77
Контроль самостоятельной работы	5/0,14	5/0,14
Самостоятельная работа (всего)	70/1,95	70/1,95
В том числе:	-	-
Реферат (при наличии)	70/1,95	70/1,95
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	27/0,75	27/0,75
<i>Контрольная работа</i>	27/0,75	27/0,75
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Экзамен	Экзамен
Общая трудоемкость	часы	144
	зачетные единицы	4

5. Содержание дисциплины (модуля).

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы нумеруются.

Тема 1. Классификация технологических процессов МЭ производства (6 часов).

Классификация и характеристика основных технологических процессов производства изделий микроэлектроники. Особенности микро- и нанoeлектронной технологии.

Тенденции и основные особенности развития современной технологии МЭ. Базовые технологические процессы МЭ.

Тема 2. Технологические процессы формирования тонкопленочных покрытий (20 часов).

Общие понятия о пленочных покрытиях, их классификация и характеристика.

Методы получения ТПП.

Физико-химические основы, технология и области применения методов вакуумно-термического испарения, ионно-плазменного распыления и термохимического осаждения ТПП. Практические способы формирования тонких и сверхтонких покрытий. Физико-химические основы, технология и области применения процессов термического окисления полупроводников. Практические методы получения защитных, сверхтолстых и подзатворных диэлектриков Физико-химические основы, технология и области применения процессов анодного и ионно-плазменного окисления. Технология получения туннельно-тонких окисных пленок.

Физико-химические основы и технология эпитаксиального наращивания монокристаллических пленок. Молекулярная эпитаксия.

Тема 3. Технологические процессы легирования полупроводников (12 часов).

Физико-химические основы и технология процессов объемного и поверхностного легирования полупроводников. Физика и математика диффузии. Диффузионные источники и методы проведения диффузионных процессов. Одно- и двухстадийные процессы диффузии.

Методы легирования ионной имплантацией. Распределение имплантированных ионов. Преимущества и недостатки имплантации. Области применения метода. Технология формирования сверхтонких и слаболегированных слоев.

Практические методы диффузионного легирования и ионной имплантации. Сравнительный анализ методов. Методы локального легирования. Области применения методов диффузионного легирования и ионной имплантации..

Тема 4. Технологические процессы формирования топологии МЭ структур методами локальной микрообработки. (10 часов).

Основные понятия и определения, классификация методов локальной микрообработки. Фотолитография, электролитография, ионолитография и рентгенолитография.

Физико-химические основы фотохимических методов обработки. Фоторезисты и их свойства.

Технологическая схема процесса фотолитографии. Назначение, физическая сущность и технология основных этапов процесса фотолитографии.

Трафаретные и лучевые методы локальной микрообработки: проекционная и контактная оптическая фотолитография, электролитография

Тема 5. Технологические процессы получения межсоединений в МЭ приборах. (8 часов).

Классификация методов получения межсоединений в технологии МЭ, их характеристика и области применения.

Дискретные методы получения межсоединений. Технология процессов термокомпрессионной, ультразвуковой и электроконтактной микросварки.

Интегральные методы получения межсоединений. Физические основы и технология процесса металлизации. Технология получения многослойных структур металл-диэлектрик

Тема 6. Технология изоляции элементов ИМС (8 часов).

Методы изоляции рп-переходом, диэлектрическая изоляция и комбинированные методы изоляции элементов ИМС. *3D*- и *ПЭТ*-технологии, их особенности, преимущества, недостатки и области применения. Технология получения *КНС*-структур и *ЭПИК*-технология изоляции. Особенности и области применения диэлектрических методов изоляции. *LOCOS* и *PLANOX* –технологии изоляции элементов микросхем. Технология щелевой изоляции – *TRENCH*-технология. Преимущества, недостатки и области применения методов.

Тема 7. Технологические схемы производства МЭ структур (36 часов).

Практическая разработка топологии элементов ИМС с микронными и субмикронными размерами. Разработка комплекта фотошаблонов для заданной топологии активных или пассивных компонентов ИМС.

Разработка технологических схем производства простейших микро- и нанозлектронных структур с различными методами изоляции. Выбор последовательности технологических процессов и технологических режимов получения металлических, полупроводниковых и диэлектрических слоев.

Разработка технологии получения сильно и слаболегированных, а также тонких и сверхтонких полупроводниковых слоев.

Расчет параметров распределения легирующей примеси в активных областях полупроводниковых структур.

Самостоятельная разработка топологии, комплекта шаблонов и технологии изготовления заданных микроэлектронных структур. Написание и оформление курсовой работы на ЭВМ с использованием современных текстовых и графических редакторов.

Тема 8. Заключительная лекция. (2 часа).

Современные тенденции развития микроэлектронной технологии. Способы увеличения быстродействия и степени интеграции

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин (вписываются разработчиком)								
		1	2	3	4	5	6			
1.	Материалы электронной техники									
2.	Методы исследования материалов и структур	1	2	3	4	5	6			

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Наименование темы	Виды занятий в часах			
			Лекц.	ПЗ	СРС, КСР	Всего
1.	1 Классификация технологических процессов МЭ производства.	1.1 Классификация и характеристика основных технологических процессов производства изделий микроэлектроники. Особенности микро- и нанoeлектронной технологии. Тенденции и основные особенности развития современной технологии МЭ. Базовые технологические процессы МЭ	2	4	14, 1	16
2.	2. Технологические процессы формирования тонкопленочных покрытий	2.1 Общие понятия о пленочных покрытиях, их классификация и характеристика. Методы получения ТПП. 2.2 Физико-химические основы, технология и области применения процессов термического окисления полупроводников. Практические методы получения защитных, сверхтолстых и подзатворных диэлектриков Физико-химические основы, технология и области применения процессов анодного и ионно-плазменного окисления. Технология получения туннельно-тонких окисных пленок. Физико-химические основы и технология эпитаксиального наращивания монокристаллических пленок. Молекулярная эпитаксия.	2	4	14,1	16
3	3. Технологические процессы легирования полупроводников.	3.1 Физико-химические основы и технология процессов объемного и поверхностного легирования полупроводников. Физика и математика диффузии. Диффузионные источники и методы проведения диффузионных процессов. Одно- и двухстадийные процессы диффузии.	1	2	7	8
4.	4 Технологические процессы формирования топологии МЭ структур методами локальной микрообработки.	4. Основные понятия и определения, классификация методов локальной микрообработки. Фотолитография, электролитография, ионолитография и рентгенолитография. Физико-химические основы фотохимических методов обработки. Фоторезисты и их свойства. Технологическая схема процесса фотолитографии. Назначение, физическая сущность и технология основных этапов процесса фотолитографии. Трафаретные и лучевые методы	4	8	28,2	32

		локальной микрообработки: проекционная и контактная оптическая фотолитография, электронолитография				
5.	4. Технологические процессы получения межсоединений в МЭ приборах.	5.1 Электропроводность металлов, время релаксации, Уравнение Больцмана. Электропроводность собственных и примесных полупроводников, температурная зависимость. Механизмы рассеяния носителей заряда. 5.2 Классификация методов получения межсоединений в технологии МЭ, их характеристика и области применения. Дискретные методы получения межсоединений. Технология процессов термокомпрессионной, ультразвуковой и электроконтактной микросварки. Интегральные методы получения межсоединений. Физические основы и технология процесса металлизации. Технология получения многослойных структур металл-диэлектрик	3	6	21	24
6.	6. Технологические схемы производства МЭ структур..	6.1 Практическая разработка топологии элементов ИМС с микронными и субмикронными размерами. Разработка комплекта фотошаблонов для заданной топологии активных или пассивных компонентов ИМС. Разработка технологических схем производства простейших микро- и нанoeлектронных структур с различными методами изоляции. Выбор последовательности технологических процессов и технологических режимов получения металлических, полупроводниковых и диэлектрических слоев	2	4	14,1	16
Всего:			14	28	97,5	144

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ

№ п/п	№ раздела и темы дисциплины (модуля)	Наименование семинаров, практических и лабораторных работ	Трудоемкость (часы)	Оценочные средства	Формируемые компетенции
1	2	3	4	5	6
1.	Тема 1 Раздел 1.1	Решение и разбор задач по теме.	4	Контрольная работа.	ОПК-1, ОПК-6

2.	Тема 2 Разделы 2.1-2.2	Решение и разбор задач по теме.	4	Контрольная работа.	ОПК-1, ОПК-6
3.	Тема 3 Раздел 3.1	Решение и разбор задач по теме.	2	Контрольная работа.	ОПК-1, ОПК-6
4.	Тема 4 Разделы 4.1-4.3	Решение и разбор задач по теме.	8	Контрольная работа.	ОПК-1, ОПК-6
5.	Тема 5 Разделы 5.1-5.3	Решение и разбор задач по теме.	6	Контрольная работа.	ОПК-1, ОПК-6
6.	Тема 6 Разделы 6.1-6.2	Решение и разбор задач по теме.	4	Контрольная работа.	ОПК-1, ОПК-6

7. Примерная тематика заданий для самостоятельной работы (реферат)

1. Классификация процессов микро- и нанотехнологии по физико-химической сущности: механический, термический, химический, корпускулярно-полевой; виду процесса: нанесение, удаление, модифицирование; характеру протекания процессов: тотальный, локальный, селективный, избирательный, анизотропный; способу активации: тепло, излучение, поле.
2. Системный подход к управлению качеством.
3. Виды термического и корпускулярно-лучевого воздействий: резистивный, лучистый и индукционный нагрев, электронные и лазерные пучки, плазма и ионные пучки.
4. Интегрированные технологические кластерные комплексы: минифабрики, нанотехнологические комплексы на основе туннельно-полевого массопереноса и модифицирования. Виды термического и корпускулярно-лучевого воздействий: резистивный, лучистый и индукционный нагрев, электронные и лазерные пучки, плазма и ионные пучки.
5. Каталитические свойства поверхности и атомно-силовое воздействие.
6. Самоформирование: интеграция физико-химических процессов на основе топохимической селективности поверхности, структурно-топологические операции на основе анизотропии, маски дифференциального действия, принцип матрицы.
7. Чистые помещения: классификация производственных помещений по чистоте воздушной среды и микроклимату, источники загрязнений, способы обеспечения и поддержания чистоты.
8. Физико-технологические и экономические ограничения миниатюризации и интеграции.
9. Вакуум: глубина вакуума, средства откачки и методы контроля.
10. Сборка микроэлектронных устройств: монтаж кристаллов, термокомпрессия, ультразвуковая микросварка, пайка выводов; оборудование для микросборки; беспроводный монтаж.

11. Оборудование и методы нанесения вещества в вакууме из молекулярных пучков: вакуум-термическое и электронно-лучевое испарение, молекулярно-лучевая эпитаксия.
12. Оборудование и методы ионно-плазменного осаждения: катодное, магнетронное, реактивное распыления; ионно- и плазмохимическое осаждение.
13. Классификация базовых методов литографии: фото-, рентгено-, электроно- и ионолитография.
14. Оборудование и методы осаждения из газовой фазы: получение поликристаллического и аморфного гидрогенизированного кремния, оксида и нитрида кремния; пиролитическое осаждение металлов; газофазная эпитаксия кремния, бинарных и многокомпонентных соединений.
15. Литографический цикл: резисты и способы их нанесения, позитивные, негативные, жидкие и сухие резисты; методы повышения адгезии, плазмостойкости; планаризация, предэкспозиционная обработка, проявление и сушка.
16. Оборудование и методы осаждения из жидкой фазы: жидкофазная эпитаксия, электрохимическое осаждение слоев.
17. Фотошаблоны. Аппаратура и способы совмещения и экспонирования. Пространственное разрешение.
18. Эволюция процессов экспонирования: высокоэффективные источники дальнего ультрафиолета, оптическая литография с фазовым сдвигом.
19. Оборудование и методы окисления в газовой и жидких средах: высокотемпературное термическое сухое и влажное окисление, электрохимическое окисление.
20. Диффузия примесей: распределение примесей при диффузии, стадии загонки и разгонки примесей, оборудование и методы диффузии из газообразных, жидких и твердых источников.
21. Ионная имплантация: распределение примесей, оборудование и методы ионной имплантации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

а) основная литература

1. Ефимов И.Е., Козырь И.Я. Основы микроэлектроники. Изд-во «Лань», 2008
2. Коваленко А.А. Основы микроэлектроники, 2010г.
3. Л.А. Коледов. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. М.: Изд-во «Техносфера», 2009 г.

б) дополнительная литература

4. Дж.М.Мартинес- Дуарт, Р.Дж.Мартин- Палма, Ф. Агулло- Руеда. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники. Пер с англ. Техносфера, 2009,368 с.
5. Л.Фостер. Нанотехнологии, наука, инновации и возможности. М., Техносфера, с.348, 2008г.
6. Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника. Мировые достижения. Сборник под редакцией д.т.н., профессора П.П.Мальцева. Москва: Техносфера,2008. – 432с.
7. В.И.Галкин, В.Е.Пелевин. Промышленная электроника и микроэлектроника. Учебное пособие, М. ;Высшая школа, 2006 г. – 350с.
8. Гаврилюк А.А., Зубрицкий С.М., Петров А.Л.. Физика металлов и сплавов. Учебное пособие. Иркутск-2009, 93с.

в) Интернет источники:

научные публикации в реферативных журналах по актуальным проблемам физики магнитных явлений и магнитным материалам электроники Электронные версии журналов: “Физика твердого тела”, “Журнал технической физики”, “Письма в журнал технической физики”, “Физика и техника полупроводников” <http://journals.ioffe.ru>.

www.nanonewsnet.ru – Сайт о нанотехнологиях в России.

www.nanodigest.ru – Интернет журнал о нанотехнологиях

www.nano-info.ru - Сайт о современных достижениях в области микро- и нанотехнологий

www.nanometer.ru – Сайт нанотехнологического сообщества ученых,

студентов и любознательных читателей

www.nano-portal.ru - Портал посвящен развитию нанотехнологий

г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы:

1. Книгафонд - библиотека онлайн чтения. www.knigafund.ru

2. ЭБС "Издательство Лань" <http://e.lanbook.com/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):

Компьютерные презентации, программа для тестирования.

10. Образовательные технологии:

№ п/п	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1.	Лекция	Вводная лекция, информация лекция, лекция с элементами дискуссии, интерактивная лекция (лекция диалог), информационная лекция с элементами обратной связи, информационная лекция с элементами проблемных ситуаций.
3.	Практическое занятие	Занятие – решение задач.

11. Оценочные средства (ОС):

11.1. Текущий контроль осуществляется в устной и письменной форме при выполнении студентами учебных заданий - решении задач и выполнении контрольных работ на протяжении всего курса.

11.2. Рубежный контроль проводится между модулями – тестирование.

11.3. Промежуточный контроль – подготовка реферата по теме из списка заданий для самостоятельной работы.

11.4. Итоговый контроль – экзамен.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника. Материалы и компоненты твердотельной электроники.»

Разработчик:



доцент

А.Л.Петров.

Программа рассмотрена на заседании кафедры электроники твердого тела

«31» января 2023г.

Протокол № 7

Зав. кафедрой Гаврилюк А.А.

